

# ESCOLA DE MICROELETRÔNICA DA PARAÍBA 2010



## DADOS DO PALESTRANTE

**Nome:** Vincent Patrick Marie Bourguet

**Filiação:** Universidade Federal do Rio Grande do Norte

**CV:** possui graduação em Diplome Universitaire de Technologie - DUT pela Université D'Evry - Val D'Essonne (1998) , graduação em Licence Ingénierie Electrique pela Université D'Evry - Val D'Essonne (1999) , mestrado em Maîtrise d'Electronique, Electrotechnique & Automa pela Université Pierre et Marie Curie (2000) , mestrado em DEA ASIME Arch. Syst. Intégrés & Microelectronique pela Université Pierre et Marie Curie (2001) , doutorado em Architecture & Conception de Systèmes Intégrés pela Université Pierre et Marie Curie (2007) e pós-doutorado pela Universidade Federal de Campina Grande (2009) . Atualmente é Professor Visitante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica. Atuando principalmente nos seguintes temas: Síntese automática, circuitos analógicos, Circuito integrado.

**Apresentação:** Casamento de componentes integrados.

### **Resumo:**

Pretende-se abordar a questão sobre as tolerâncias relativas ao valor de componentes integrados (absoluto/relativo) e a representação matemática desses fenômenos estatísticos. Serão discutidas as causas e serão mostradas algumas técnicas de leiaute para melhorar o casamento entre os componentes.

Pretende-se mostrar um pouco sobre o simulador SPICE/ELDO (histórico, sintaxe) apresentar brevemente modelos de transistor MOS para simulação (Bsim3), explicar simulação pior caso e Monte Carlo. Gostaria também de mostrar como as simulações MC são usadas para a modelagem de mismatch nas tecnologias reais, em particular na ST que eu conheço.